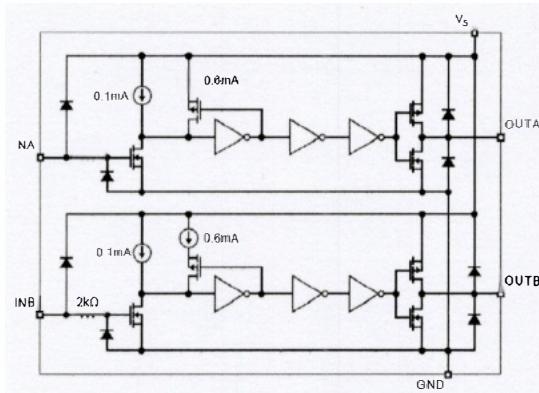




## XA-4427 型双路同相MOSFET驱动器规格书

## 主要特点:

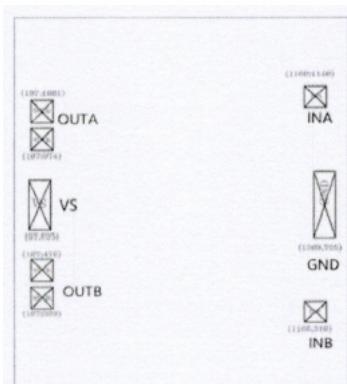
- 高压BICMOS工艺
- 双路1.5A峰值输出电流
- 低静态电流  
4mA, 逻辑高输入  
0.4mA, 逻辑低输入
- 快速开关时间25ns
- 延迟时间40ns
- 7Ω输出阻抗
- 高可靠性



## 产品描述:

芯片采用高压、低功耗BICMOS硅工艺制造，包含两路独立的同相驱动器，可将TTL/CMOS信号转换为4.5~18V输出。主要用于驱动功率MOSFET，也可用于驱动电容、电感或电阻等需要低阻抗、大电流、快速开关的应用。可有效替代国外MIC4427/MAX4427等驱动器电路。

## 芯片尺寸:



芯片尺寸	X	Y	单位
焊盘尺寸/栅极	1350	1500	um
最大额定值: Ta=25°C	80	80	um



参数	符合	额定值	单位
电源电压	V <sub>S</sub>	22	V
输入电压	V <sub>IN</sub>	V <sub>S</sub> +0.3V~GND-5V	V
结温	T <sub>j</sub>	175	°C

### 主要电特性:

除另有规定外, 4.5V≤V<sub>S</sub>≤18V, T<sub>a</sub>= 25°C

	参数	符号	条件	Min	Typ	Max	单位
输入特性	逻辑1输入电平	V <sub>IH</sub>	-	2.4	1.4		V
	逻辑0输入电平	V <sub>IL</sub>	-		1.1	0.8	V
	输入电流	I <sub>N</sub>	0V≤V <sub>IN</sub> ≤V <sub>S</sub>	-1		1	μA
输出特性	输出高电平	V <sub>OH</sub>		V <sub>S</sub> -0.025			V
	输出低电平	V <sub>OL</sub>	-			0.025	V
	输出电阻	R <sub>O</sub>	I <sub>out</sub> =10mA, V <sub>S</sub> =18V	6	10		Ω
开关时间	上升时间	t <sub>R</sub>	C <sub>L</sub> =1nF	23	40		ns
	下降时间	t <sub>F</sub>	C <sub>L</sub> =1nF	27	40		ns
	延迟时间	t <sub>D1</sub>	C <sub>L</sub> =1nF	26	40		ns
	延迟时间	t <sub>D2</sub>	C <sub>L</sub> =1nF	38	60		ns
电源特性	电源电流	I <sub>S</sub>	V <sub>IN</sub> =3V(双输入端)	1.4	8		
			V <sub>IN</sub> =0V(双输入端)		0.18		mA

### 包装要求:

芯片应包装在专用的裸芯片盒里面, 采用防潮、防震和防静电包装。

芯片外包装容器上应注明:

- a) 芯片型号;
- b) 检验批识别代码;
- c) 数量。

### 贮存要求:

裸芯片应贮存在充有氮气的干燥柜里。

### 运输要求:

芯片运输过程中应防雨、雪淋袭和机械撞击,